

SS 125

Verwendung: Mittelschneller Silizium-npn-Planar-Epitaxie-Schalttransistor für die Verwendung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen bei Umgebungstemperaturen ϑ_a von -40°C bis $+125^\circ\text{C}$

Abmessungen: Bauform B 3/25 - 3a,
TGL 11 811

Kollektor am Gehäuse

Masse ≈ 1 g

Zulässige Höchstwerte gültig bis $\vartheta_{j\text{max}}$

$U_{CB0} = 30$ V $P_{\text{tot}} = 600$ mW

$U_{CE0} = 25$ V bei $\vartheta_a = 25^\circ\text{C}$

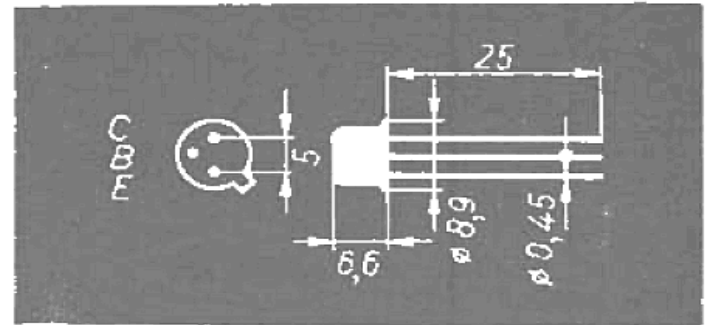
$U_{EB0} = 5$ V $P_{\text{tot}} = 2,5$ W

$I_C = 500$ mA bei $\vartheta_C = 25^\circ\text{C}$

bei $t_{\text{av}} = 20$ ms $\vartheta_j = 175^\circ\text{C}$

$\hat{I}_C = 700$ mA $\vartheta_a = 125^\circ\text{C}$

$I_B = 250$ mA



Wärmewiderstand $R_{\text{thja}} \leq 250 \frac{\text{grad}}{\text{W}}$

$R_{\text{thjc}} \leq 60 \frac{\text{grad}}{\text{W}}$

Kennwerte für $\vartheta_a = 25^\circ\text{C}$ -5 grad

	Min.	Typ	Max.	Meßbedingungen	Stromverstärkungsgruppen
Restströme					
I_{CB0}			25 nA	$U_{CB} = 20$ V	
Durchbruchspannung					
$U_{(BR)CE0}$	25 V			$I_C = 50$ mA	
Spannungen					
U_{CB}	30 V			$I_C = 5 \mu\text{A}$	
U_{EB}	5 V			$I_E = 5 \mu\text{A}$	
Gleichstromverstärkung					
B	18 29 45		35 55 88	$U_{CE} = 1$ V, $I_C = 400$ mA (Messung erfolgt impulsmäßig)	A B C
Übergangsfrequenz					
f_T	30 MHz			$U_{CE} = 12$ V, $I_C = 50$ mA, $f = 15$ MHz	

Bestellbeispiel für einen Transistor der Stromverstärkungsgruppe A

Transistor SS 125